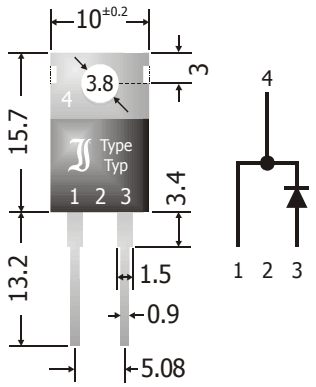
SBT2620 ... SBT2640

Schottky Barrier Rectifiers – Single Diode
Schottky-Barrier-Gleichrichter – Einzeldiode

Version 2009-09-21



Dimensions - Maße [mm]

Nominal current Nennstrom	26 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	TO-220AC
Weight approx. Gewicht ca.	1.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	

Maximum ratings and Characteristics **Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] [1]	
			I_F = 5 A	I_F = 26 A
SBT2620	20	20	< 0.50	< 0.59
SBT2630	30	30	< 0.50	< 0.59
SBT2640	40	40	< 0.50	< 0.59

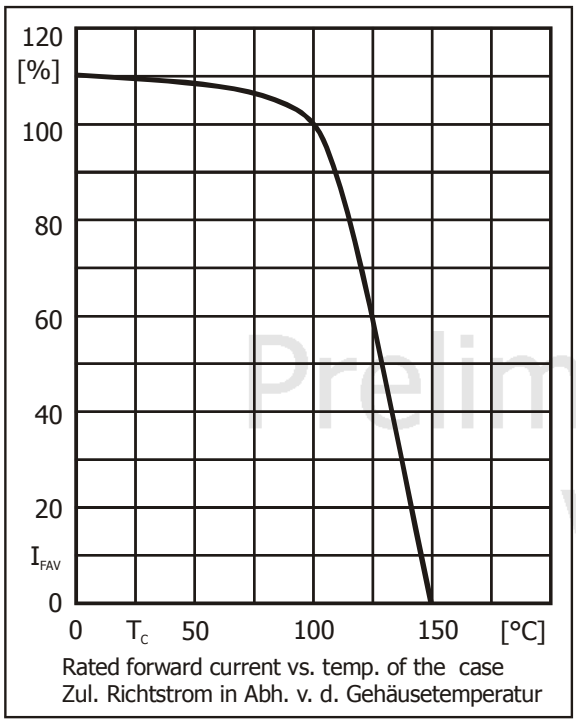
Preliminary
Vorläufig

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		T_C = 100°C	I_{FAV}	26 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	I_{FRM}	60 A [2]
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	SBT1820... SBT1840	T_A = 25°C	I_{FSM}	290/330 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms		T_A = 25°C	i^2t	420 A^2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb			T_j T_j	-50...+150°C ≤ 200°C

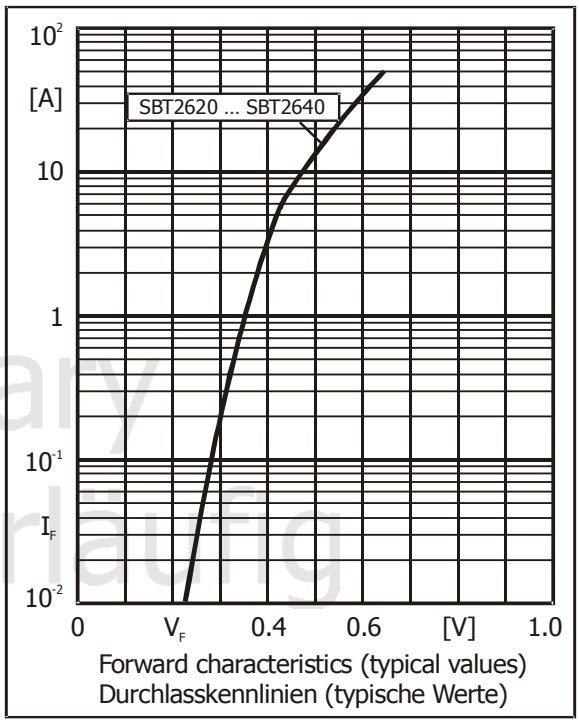
1 T_j = 25°C
2 Max. temperature of the case T_C = 100°C – Max. Temperatur des Gehäuses T_C = 100°C

© Diotec Semiconductor AG

Characteristics				**Kennwerte**
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25°C T_j = 100°C	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 500 µA typ. 30 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 1.5 K/W



Rated forward current vs. temp. of the case
Zul. Richtstrom in Abh. v. d. Gehäusetemperatur



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

Preliminary
Vorläufig

 © Diotec Semiconductor AG